

سنتر، مشخصه‌یابی و بررسی دمای گذار نظم بار نانوذرات $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4(x \approx 0/33)$

مهدى حسن شاه، * محمد ابراهيم قاضى؛ دانشگاه شهرود، دانشکده فيزيك
بهرام بهراميان؛ دانشگاه شهرود، دانشکده شيمي
محمدحسين احسانى؛ دانشگاه سمنان، گروه فيزيك

چکیده

نيكلات با فرمول عمومي $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ و با درصد آلايش $x \approx 0/33$ به روش سل-ژل تهيه شد. با تعديل در دمای بازپخت و پارامترهای رشد سعی شد ذراتی با اندازه‌های دانه متفاوت ايجاد شود. ساختار بلوری و خصوصیات فيزيکی آن‌ها بهوسیله تکنيک‌های طيف پراش پرتو X ، تبديل فوريه طيف عبوری مادون قرمز، طيف سنجی پاشندگی انرژی پرتو X ساطع شده، ميكروسكوب الکتروني روبيشی و اندازه‌گيری مقاومت الکتریکی با دما بررسی شد. نتایج XRD و بررسی مورفولوژی سطح نمونه‌ها با SEM نشان داد که کمترین دمای بازپختی که در آن فاز خالص تتراترونال مورد نظر تشکيل می‌شود، ۹۲۰ درجه سانتی‌گراد است. با افزایش دمای بازپخت، اندازه بلورک‌ها از 50 nm تا $2\mu\text{m}$ افزایش یافت. اندازه‌گیری طيف عبور اپتیکی (FTIR) نمونه‌ها نشان داد طول پیوند O-Ni-O در نمونه دارای اندازه بلورک کوچکتر، کوتاهتر است که این نتیجه در تطابق با کاهش ثابت‌های شبکه a و c با کاهش دمای بازپخت و اندازه بلورک‌ها است. نتایج اندازه‌گیری‌های مقاومت الکتریکی با دما نشان داد که دمای نظم بار با کاهش اندازه ذرات کاهش می‌یابد.

مقدمه

پس از کشف ابررساناهای دمای زیاد، $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ ، نیكلات‌ها، $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ توجه زیادی را به خود جلب کرده است. $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ که ساختاری شبیه به $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ دارد، در دماهای پایین در عوض بروز پدیده ابررسانایی، با توجه به مقدار آلايش، x ، نظم بار را نشان می‌دهد [۱، ۲]. ترکیبات اولیه آن‌ها، K_2NiF_4 و La_2CuO_4 هر دو عایق‌های مات آنتی‌فرومغناطیس با ساختاری لایه‌ای پروسکایت (تتراترونال، با گروه فضایی $14/mmm$) هستند. گاف نواری (یعنی گاف نواری بین حالت‌های اشغال نشده ۳d عناصر Cu/Ni و حالت‌های اشغال شده 2p اکسیژن) در La_2NiO_4 تقریباً $3/5\text{ eV}$ ، دو برابر بزرگتر از مقدار آن در La_2CuO_4 است [۳]. جفت‌شدنی اسپینی درون هر کدام از صفحات Ni/CuO_2 خیلی قوی‌تر از اسپین‌هایی است که در بین صفحات مجاور قرار می‌گیرند [۴]. با تزریق حفره کافی درون این سیستم‌ها که

واژه‌های کلیدی: نیكلات، سل-ژل، نظم بار، خواص الکتریکی

دریافت ۹۱/۹/۱۸ پذیرش ۹۲/۶/۲۵

*نویسنده مسئول mghazi@shahroodut.ac.ir

با جانشینی یون‌های Sr^{2+} به جای یون‌های La^{3+} انجام می‌شود، La_2NiO_4 و La_2CuO_4 رفتار الکتریکی متفاوتی از خود نشان می‌دهند [۵، [۶].

در نیکلایت‌ها رفتار فلزی در حدود $x=1$ ظاهر می‌شود، در صورتی که ترکیب $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ برای $x \leq 0.55$ ابررسانا می‌شود. نتایج پراکنده نوترونی، نظم بار را در سیستم $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ برای $x \geq 0.55$ نشان می‌دهد. در $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ ابررساناپایی برای هیچ مقداری از x مشاهده نشده است. به‌نظر می‌رسد که حامل‌های حفره آلایش شده، تفاوت رفتاری چشمگیری را بین نیکلایت‌ها و کوپرایت‌ها ایجاد می‌کند [۷، [۸]. وجود نداشتن ابررساناپایی در $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ که‌ای، احتمالاً به‌دلیل اندازه کوچک پلaron در این سیستم است [۹]. تفاوت در خواص الکتریکی و مغناطیسی این دو سیستم به جفت‌شدن قوی الکترون شبکه و تحرک کم حامل‌های بار نیکلات‌ها نسبت داده می‌شود [۱۰].

حفره‌های آلایش شده در نیکلایت‌ها را که می‌توان با جای‌گزینی یون‌هایی دو بار مثبت از قبیل Ca^{2+} ، Sr^{2+} یا Ba^{2+} با یون‌های La^{3+} ایجاد کرد، در دماهای کم تمایل به منظم شدن در راستاهای خاصی درون سیستم را دارند که دمای گذار به این فاز نظمدار را دمای نظم بار می‌نامند. در نمونه کپهای $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ با $x=1/3$ ، دمای گذار به فاز نظم بار در حدود K_{40} است. از آنجاکه نظم بار در سیستم نیکلایت‌ها یک طبیعت دو بعدی دارد، بنا بر این یک فرم شبه نواری دارد که نوار بار^۱ نامیده می‌شود. نتایج حاصل از پراکنده نوترون نشان می‌دهد چنان‌که تراکم حفره افزایش می‌یابد، نظم آنتی‌فرومغناطیس سه بعدی به هم‌ستگی دو بعدی درون صفحات NiO_2 تبدیل می‌شود [۱۱].

در این تحقیق به سنتر ترکیب $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ با $x=1/3$ بروش سل-ژل سنتر شده‌اند. در مراحل مختلف سنتر، بر روی ساختار و اندازه ذرات بررسی شده است. هدف تهیه ذرات با اندازه کمتر و بررسی وابستگی دمای نظم بار به اندازه ذرات است.

مراحل آزمایشگاهی

نانوذرات $(\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4)$ ($x \approx 0.33$) بروش سل-ژل سنتر شده‌اند.

به عنوان مواد اولیه $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Ni} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{La}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ به کار برده شده‌اند. در این روش نیترات‌های فلزی (La, Sr, Ni) با استوکیومتری معین (جمع غلضت یون‌های فلزی $M = M/23 - 0.23$) در صد میلی‌لیتر آب دوبار یونیزه حل شدند. سپس مقدار مشخصی اسید نیتریک غلیظ و اتیلن گلیکول به محلول اضافه شده و در دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد بر روی هات پلیت به آهستگی دی‌هیدرولیز شد تا ژل تهیه شود. ژل تهیه شده در ۴۰۰ درجه سانتی‌گراد برای چند ساعت حرارت داده شد تا اجزای آلی باقی مانده در محلول حذف شوند. سپس ماده حاصل در مجاورت هوا برای ۶ ساعت در دماهای ۱۰۰۰، ۹۲۰، ۸۰۰ و ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد برای تهیه نانوذرات باز پخت شد. نمونه‌های باز پخت شده در دماهای مختلف به ترتیب

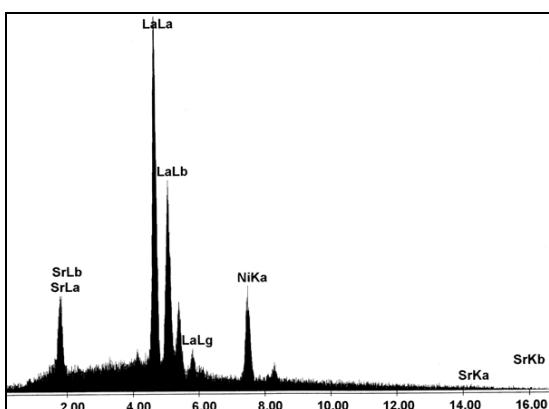
^۱. Charge stripe

با N-۸۰۰، N-۹۲۰، N-۱۰۰۰ و N-۱۳۰۰ نامگذاری شدن. بهمنظور بررسی خواص ساختاری، خواص پیوندی، مورفولوژی و غلظت عناصر ترکیب بهتری از XRD، FTIR و FE-SEM و EDX استفاده شده است. اندازه‌گیری‌های مقاومت الکتریکی نمونه‌ها با روش چهار پایانه‌ای انجام شده است.

نتایج و بحث

طیف‌سنجی پاشندگی انرژی پرتو X^۱

EDX روشی تحلیلی است که برای محاسبه مقادیر اجزای سازنده عناصر در ترکیب یا تحلیل مشخصه‌های شیمیایی نمونه بهکار می‌رود. تعداد و انرژی پرتوهای X ساطع شده با دستگاه EDX اندازه‌گیری شده که این امکان مشخص کردن ترکیب عنصری نمونه را می‌دهد. طیف EDX نمونه N-۱۰۰۰ در شکل ۱ نمایش داده شده است. تحلیل نتایج درصد اتمی EDX نشان داد که درصد عناصر موجود در ترکیب خیلی نزدیک مقادیر مورد انتظار است.

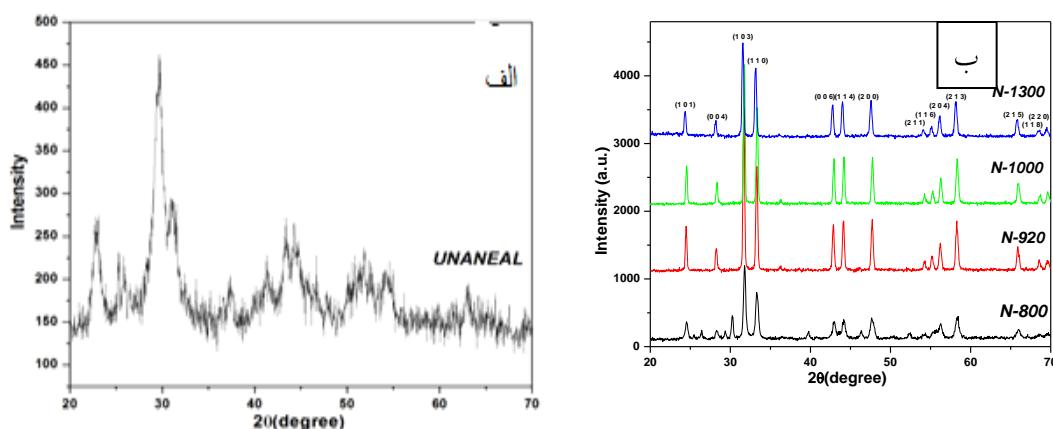


شکل ۱. آنالیز EDX نمونه N-۱۰۰۰

خواص ساختاری

بهمنظور اطلاع از ساختار نمونه‌های رشد داده شده، از دستگاه XRD با گسیل خط طیفی $\text{CuK}\alpha$ با طول موج ۱/۵۴۰۵ آنگستروم استفاده شده است. طرح‌های پراش نمونه‌ها در شکل ۲ نشان داده شده است. موقعیت پیک‌های ظاهر شده در طیف متناظر با پیک‌های مربوط به $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ ($x \approx 0.33$) با ساختار تتراتوگونال است. طیف‌های XRD نمونه‌ها نشان می‌دهد با افزایش دمای بازپخت، شدت قله‌ها در طیف پراش افزایش و پهنای قله‌های حاصل از پراش پرتو X در نیمه حداکثر کاهش می‌یابد، که این می‌تواند بیان‌گر افزایش اندازه بلورک‌ها و بروز خاصیت بلوری باشد.

^۱. Energy dispersive X-ray spectroscopy



شکل ۲. طیف‌های XRD (الف) نمونه بدون باز پخت، (ب) نمونه‌های باز پخت شده در دماهای مختلف

در این نمونه‌های بس بلوری اندازه متوسط بلورک‌ها را می‌توان با استفاده از رابطه شر [۱۲] محاسبه کرد:

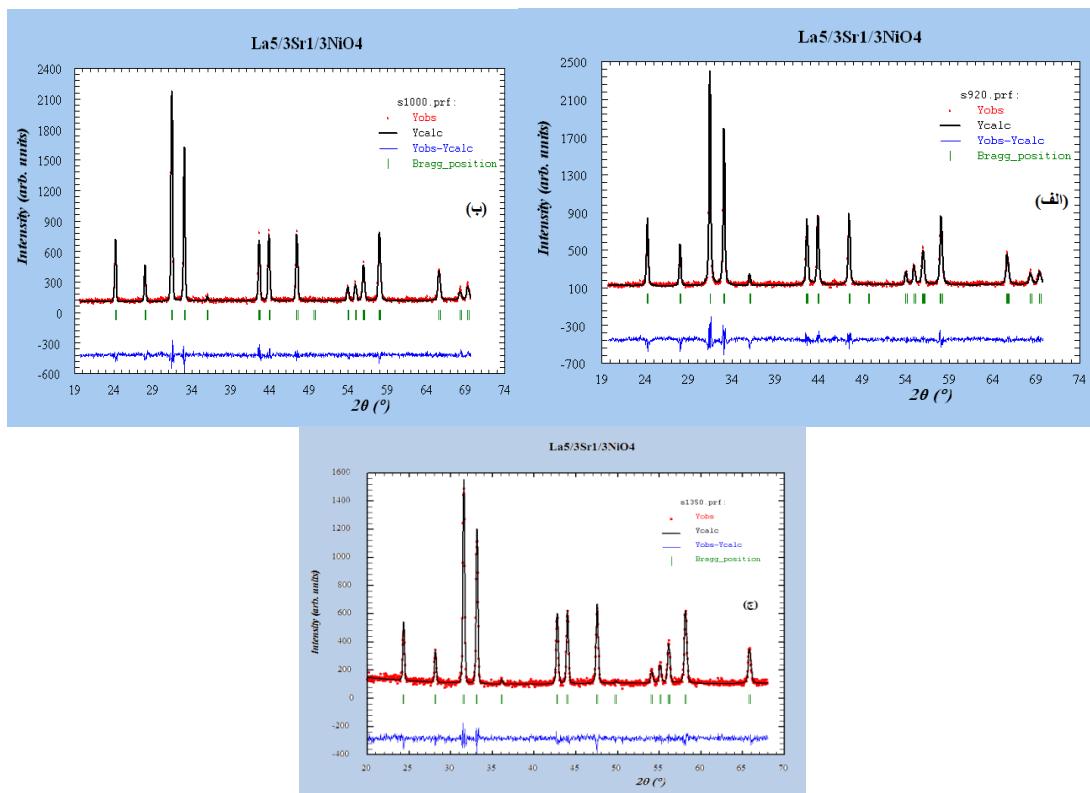
$$D = \frac{0.9\lambda}{\beta \cos \theta}$$

در این رابطه D اندازه بلورک‌ها، β تمام پهنا در نیمه حداقل شدت (FWHM)، و λ طول موج پرتو X است. برای نمونه‌های باز پخت شده در دمای ۸۰۰، ۹۲۰، ۱۰۰۰ و ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد، اندازه بلورک‌ها به ترتیب حدود ۳۵/۵، ۴۷/۶، ۵۸/۷ و ۷۷/۸ نانومتر بدست آمد که نشان‌دهنده افزایش اندازه بلورک‌ها با افزایش دمای باز پخت است.

در شکل ۳ طرح‌های پراش XRD به همراه تحلیل ریتولد نمونه‌های N-۹۲۰، N-۱۰۰۰ و N-۱۳۰۰ نشان داده شده است. از برآشن داده‌ها با ریتولد، ساختار نمونه‌ها تطبیق خوبی با ساختار گزارش شده K_2NiF_4 با گروه فضایی $14/mmm$ نشان می‌دهد. از تحلیل ریتولد ثابت‌های شبکه نیز محاسبه شد که در جدول ۱ گزارش شده است. از مقایسه ثابت‌های شبکه با یکدیگر مشاهده می‌شود که با افزایش دمای بازپخت از ۹۲۰ به ۱۰۰۰ درجه سانتی‌گراد، ثابت‌های a و c افزایش یافته است و بهترین آن حجم یاخته نیز افزایش یافته است. اما با افزایش دما از ۱۰۰۰ به ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد، ثابت‌های a و c کاهش یافته است و در نتیجه حجم یاخته هم کاهش یافته است. این تغییرات احتمالاً به این دلیل است که در بازپخت نهایی دانه‌ها بزرگتر و تهی جاها و نواقص شبکه کمتر شده که منجر به کاهش حجم یاخته واحد شده است.

جدول ۱. ثابت‌های شبکه a و c برای نمونه‌های مختلف و v حجم یاخته مربوط به آن‌ها بر اساس تحلیل ریتولد

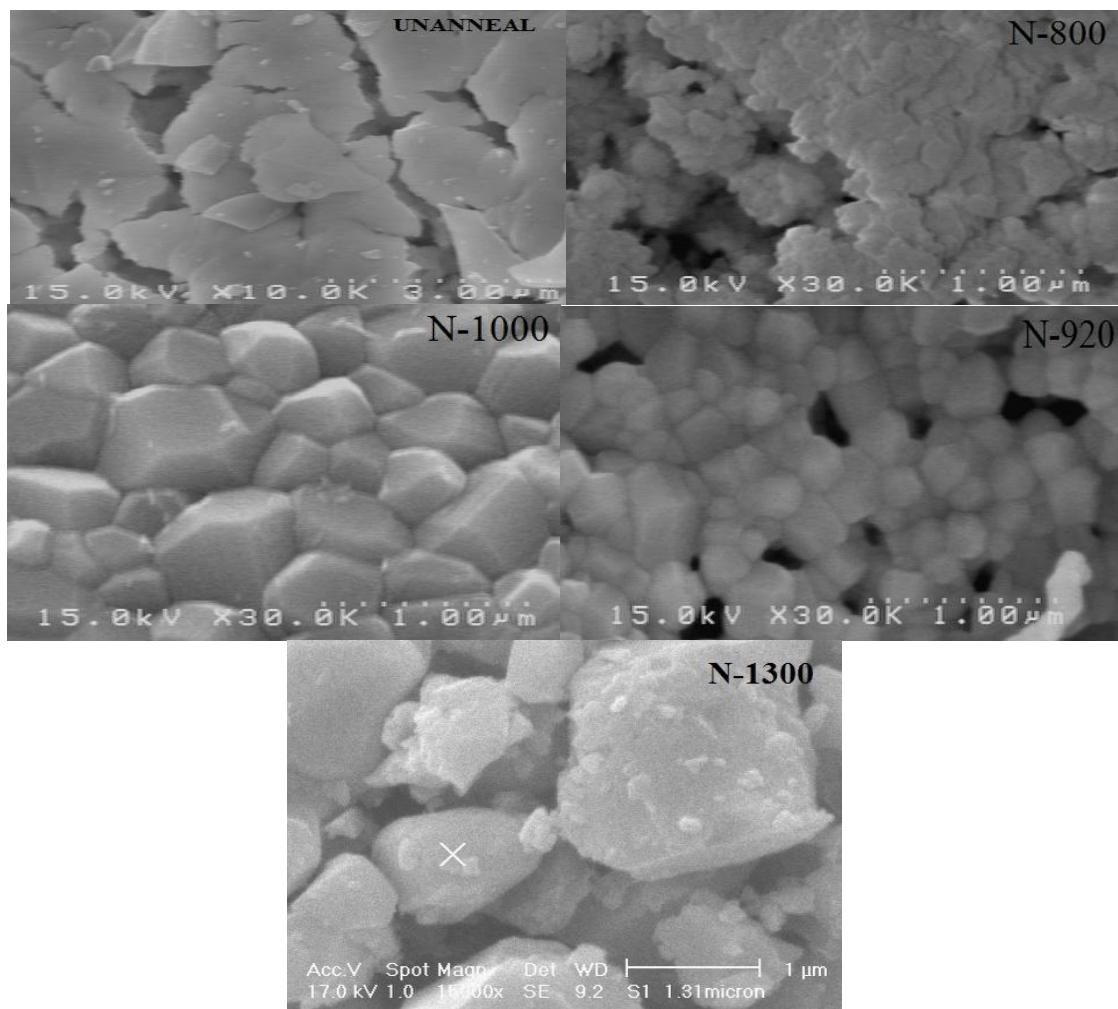
نمونه	N-۹۲۰	N-۱۰۰۰	N-۱۳۰۰
a=b(Å)	۳/۸۲۹	۳/۸۲۳	۳/۸۲۸
c(Å)	۱۲/۷۳۱	۱۲/۷۳۳	۱۲/۷۰۱
V(Å³)	۱۸۶/۶۱۷	۱۸۷/۰۳۷	۱۸۶/۰۹۶



شکل ۳. الف، ب و ج) الگوی‌های پراش اشعه X داده‌های تجربی به همراه تحلیل ریتولد، به ترتیب برای نمونه‌های N-۹۲۰، N-۱۰۰۰ و N-۱۳۰۰

مورفولوژی

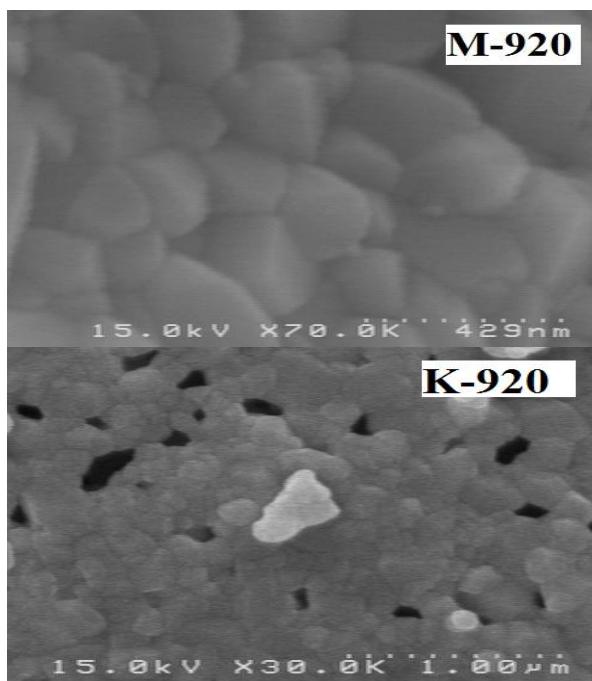
برای بررسی مورفولوژی سطح پودرهای تولید شده، از میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل Leo1455VP استفاده شد. تصاویر مربوط به مورفولوژی سطح نمونه‌های بدون بازپخت و با دماهای بازپخت ۹۲۰، ۸۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد در شکل ۴ نشان داده شده است. نمونه بدون باز پخت شامل ذره‌هایی با اندازه ۵۰ nm است. نمونه باز پخت شده در دمای ۸۰۰ درجه سانتی‌گراد متشکل از نانوذراتی با قطر میانگین ۸۰ nm است. در این دما چنان‌چه از طرح پراش نیز مشاهده می‌شود هنوز فاز خالص را نمی‌توان مشاهده کرد و به علاوه ذرات بهشت بهم چسبیده و مرز مشخصی را نمی‌توان بین آن‌ها تمیز داد. افزایش در دمای باز پخت تا ۹۲۰ درجه سانتی‌گراد منجر به تشکیل نانوذراتی با قطر میانگین ۴۰ nm می‌شود که این دمای بازپخت، پایین‌ترین دمایی است که در آن ذرات دارای مرزهای مشخص بین یکدیگر و فاز خالص ساختار تتراگونال تشکیل می‌شود. با افزایش بیشتر دمای باز پخت تا ۱۰۰۰ و ۱۳۰۰ درجه سانتی‌گراد ذراتی با قطر میانگین ۳۰۰ nm و ۲ μm تشکیل شده‌اند که در این حالت باز هم شرایط فوق قابل مشاهده است با این تفاوت که اندازه ذرات نسبت به حالت قبل کمی بزرگتر شده است. مقایسه تصاویر نشان می‌دهند با افزایش دمای باز پخت اندازه ذرات افزایش می‌یابد و مرز بین ذرات مشخص تر و توزیع آن‌ها یکنواخت‌تر می‌گردد.



شکل ۴. تصاویر FE-SEM برای نمونه‌های بدون باز پخت، N-۸۰۰، N-۹۲۰، N-۱۰۰۰ و N-۱۳۰۰

بررسی تغییر پارامترهای رشد در سنتر نانوذرات

برای بررسی اثر تغییر دمای سل به ژل، دو نمونه K-۹۲۰ و M-۹۲۰ به ترتیب با افزایش دمای سل به ژل از ۸۰ درجه سانتی‌گراد به ۱۰۰ و ۱۳۰ درجه سانتی‌گراد آماده شدند که تصاویر FE-SEM مربوط به آن‌ها در شکل ۵ مشاهده می‌شود. تصویر نمونه K-۹۲۰ نشان می‌دهد که با افزایش دمای سل از ۸۰ به ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد ذراتی با اندازه کوچکتر و یکنواختی بیشتر (کلوخه‌ها تقریباً حذف شده‌اند) به دست می‌آید. در واقع با افزایش دمای سل ذرات انرژی بیشتری پیدا می‌کنند و الیگومرها ریزتری حاصل می‌شود. درنتیجه سل سریع‌تر شفاف می‌شود و درنهایت الكل بیشتری در اطراف ذرات الکوکسیدی کوچک شده جذب سطحی می‌شود، به عبارت دیگر حلal پوشی قوی‌تری انجام می‌شود. با حلal پوشی بیشتر، فعالیت الیگومرها برای هیدرولیز و جذب آب افزایش می‌یابد که منجر به کوتاه شدن زمان تشکیل ژل و نیز زمان تراکم می‌شود [۱۳].

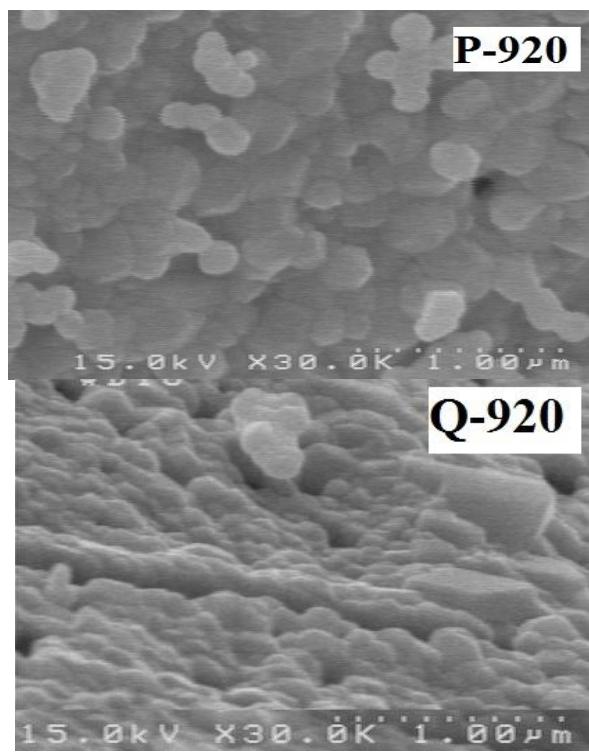


شکل ۵. تصاویر FE-SEM مربوط به نمونه‌های K-۹۲۰ و M-۹۲۰

چنان‌که در تصویر نمونه M-۹۲۰ دیده می‌شود، با افزایش بیشتر دمای سل به ۱۳۰ درجه سانتی‌گراد، اندازه ذرات افزایش یافته است. در حقیقت هنگامی که دمای سل افزایش می‌یابد، در عین این‌که باعث می‌شود تا بلورهای ریزتری به‌دست آیند بهمان اندازه از ضخامت لایه مضاعف الکتریکی که عاملی برای ایجاد دافعه بین ذرات است، کاسته می‌شود. بنا بر این بلورهای کوچک با جاذبه بیشتری با هم برهم کنش می‌کنند و منجر به تولید ذرات درشت‌تر می‌شود. با افزایش هر چه بیشتر دمای سل دافعه الکتروستاتیک کاهش می‌یابد. در نتیجه ذرات بمواسطه نیروی واندروالسی تمایل بیشتری به‌سمت یکدیگر پیدا می‌کنند که باعث بزرگ‌تر شدن اندازه نهایی ذرات و به وجود آمدن کلوخه‌های بزرگ‌تر می‌شود [۱۴].

برای بررسی تغییر دمای خشکسازی سل نمونه‌ای مطابق با شرایط قبلی آماده شد. سپس تا دمای ۱۳۰ درجه سانتی‌گراد به‌طور غیرمستقیم حرارت داده شد و ژل چسبناک آمده شده در همین دما حرارت مستقیم داده می‌شود تا ژل چسبناک به پودر تبدیل شود. در این هنگام پودر حاصل به دو قسمت تقسیم شد:

نمونه اول: برای خشکسازی پودر آمده شده از مرحله قبل، آن را در دمای ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد برای چندین ساعت حرارت می‌دهیم سپس آن را در دمای ۹۲۰ درجه سانتی‌گراد برای ۶ ساعت بازپخت می‌کنیم. این نمونه P-920 نام‌گذاری شد که تصویر FE-SEM آن در شکل ۶ مشاهده می‌شود. نمونه دوم: پودر حاصل از مرحله قبل را به مدت ۸ ساعت در کوره در دمای ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد حرارت می‌دهیم و سپس در دمای ۹۲۰ درجه سانتی‌گراد برای ۶ ساعت بازپخت می‌کنیم. این نمونه Q-920 نام‌گذاری شد که تصویر FE-SEM مربوط به آن نیز در شکل ۶ مشاهده می‌شود.

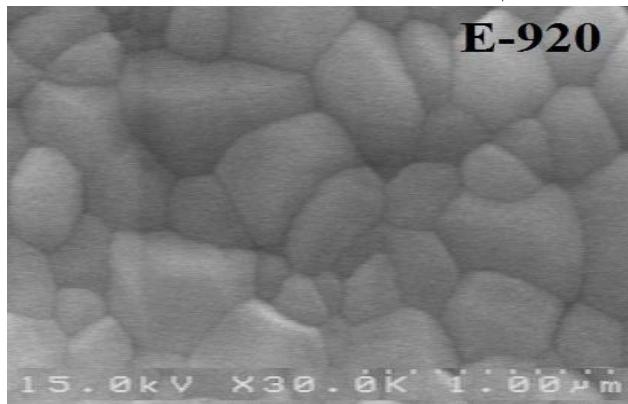


شکل ۶- تصاویر FE-SEM مریبوط به نمونه‌های P-920 و Q-920.

روش خشک کردن می‌تواند اطلاعات مفیدی را درباره بر هم کنش بین ذرات در طول فرآیند خشکسازی فراهم کند. چنان‌که در شکل ۶ دیده می‌شود، تشکیل جزایری که از تجمع ذرات نزدیک به هم ایجاد می‌شود نشان می‌دهد که نیروی مویینگی قوی در طول فرآیند خشکسازی ایجاد می‌شود [۱۳]. این فرآیند را به این روش می‌توان توضیح داد که، حذف مولکول‌های آب در طول فرآیند خشکسازی به‌طور پیوسته ادامه می‌یابد. حذف مولکول‌های آب در طول فرآیند باعث افزایش غلظت سل و همچنین ایجاد مایعی چسبناک می‌شود، که منجر به نزدیک شدن ذرات به یکدیگر می‌شود. در نقطه‌ای بحرانی، این ذرات در تماس با یکدیگر قرار می‌گیرند و برای رسیدن به پایداری بیشتر، ذرات ریزی را به وجود می‌آورند. نیروهای واندروالس و مویینگی بر نیروهای جاذبه که روی این نانو ذرات اعمال می‌شود، غالبه می‌کند [۱۶، ۱۵]. تهی جaha و ترکهایی در حد میکرو که در منطقه‌های تجمع ذرات مشاهده شده بود با تغییر سطحی آبی که به‌طور فیزیکی جذب سطح شده، ایجاد شده است. تجدید آرایش این نانوذرات می‌تواند به‌دلیل پدیده‌های ترموفورسیس و حرکت دورانی سیال در حد میکرو باشد، چنان‌که به‌وسیله اسکاندر پیشنهاد شده است [۱۷].

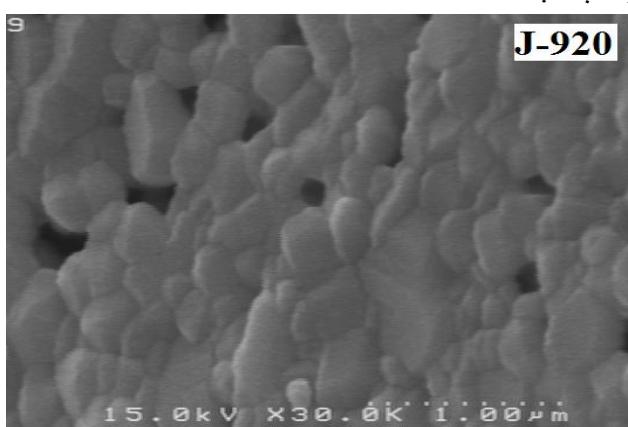
از مقایسه تصاویر نمونه‌های P و Q به‌وضوح مشاهده می‌شود که با تغییر روش خشکسازی نمونه Q دارای مورفولوژی سطح به مراتب بهتر نسبت به نمونه P است ضمن این‌که با کاهش دما و افزایش زمان خشکسازی، ذرات دارای مرز مشخص‌تری است. اما هر دو نمونه از یکنواختی خوبی برخوردارند هر چند که در اندازه ذرات تغییرات چشمگیری مشاهده نمی‌شود.

برای بررسی اثر تغییر حلال، بهجای آب دو بار یونیزه از اتانول به عنوان حلال استفاده می‌کنیم. این نمونه E-920 نامگذاری شد، که تصویر FE-SEM آن در شکل ۷ نشان داده شده است. از مقایسه نمونه E-920 با نمونه N-920 بهوضوح مشاهده می‌شود که اندازه ذرات در این نمونه افزایش چشمگیری داشته است ضمن این‌که یکنواختی ذرات کاهش یافته و کلوخه‌های بیشتری در تصویر مشاهده می‌شود. که این مسئله می‌تواند بهدلیل حذف مولکول‌های آب از سیستم باشد.



شکل ۷. تصویر FE-SEM مربوط به نمونه E-920

برای بررسی تغییراتی که از سنتر نانوذرات با استفاده از امواج ماکروویو ایجاد می‌شود محلول با همان شرایط قبلی آمده شد فقط در مرحله آمده‌سازی سل از اتیلن گلیکول و اسید نیتریک استفاده نشد. این نمونه J-920 نامگذاری شد، که تصویر FE-SEM مربوط به آن در شکل ۸ قابل رویت است. مقایسه تصاویر FE-SEM نمونه خشک شده با مایکروویو و نمونه‌های قبلی نشان می‌دهد هر چند که به‌نظر می‌آید توزیع اندازه ذرات یکنواخت‌تر شده است ولی ذرات در یک راستا کشیده شده‌اند. این ممکن است به بهدلیل ارتعاش دو قطبی‌ها در راستای میدان در فرآیند رشد باشد.



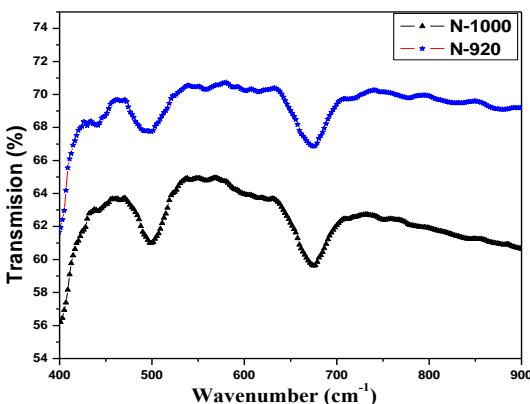
شکل ۸. تصویر FE-SEM مربوط به نمونه J-920

بهطورکلی از مقایسه تصاویر FE-SEM می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش دمای بازپخت فقط تا مقدار معینی اندازه ذرات کاهش می‌یابد و با کاهش بیشتر دما، فاز موردنظر تشکیل نشده و بلورینگی از بین می‌رود. اما از طرف دیگر افزایش دمای خشکسازی و بازپخت باعث افزایش اندازه ذرات می‌شود. با توجه به این آزمایش‌ها و

تصاویر FE-SEM بعنصر می‌رسد که دمای ۹۲۰ درجه سانتی‌گراد دمای مناسبی است. چنان‌که در تصاویر نیز مشاهده شد با تغییر دمای خشکسازی و همچنین تغییر روش خشکسازی و حتی با تغییر دمای بازپخت نتوانستیم اندازه ذرات را از مقدار معینی کوچکتر کنیم هر چند که با اعمال این تغییرات در ذرات تولیدی از نظر مورفولوژی سطح تفاوت‌های چشمگیری مشاهده شد. با تغییر حال نتوانستیم توفیق چندانی در کوچک کردن اندازه ذرات بعده‌است آوریم، هر چند که در اینجا نیز در مورفولوژی سطح تغییراتی مشاهده شد. بهطورکلی برای دستیابی به نانوذراتی با کیفیت، بهتر است دمای آماده‌سازی سل به ژل و دمای خشکسازی حتی‌المقدور کم و بهجای آن‌که دما را افزایش دهیم مدت زمان آماده‌سازی سل به ژل و خشکسازی را افزایش دهیم. در روش خشکسازی با ماکروویو تقریباً ۲۵ ساعت زمان رسیدن به نانوذرات کاهش می‌یابد ولی چنان‌که در تصاویر مربوط به ماکروویو مشاهده شد اندازه ذرات در مقایسه با روش‌های دیگر خشکسازی، تغییر فاحشی را نشان نمی‌دهد.

خواص پیوندی

بهمنظور بررسی نوع پیوندهای موجود در نمونه‌ها و بهدهست آوردن اطلاعاتی در مورد ساختار فازی آن‌ها از نمونه‌های N-۹۲۰ و N-۱۰۰۰ با دستگاه تبدیل فوریه طیفسنجی مادون قرمز مدل ۸۴۰۰ S-Shimadzu طبف مادون قرمز گرفته شد که در شکل ۹ نشان داده شده است. چنان‌که در شکل دیده می‌شود دو قله عبور در cm^{-1} ۶۷۲ و $498 cm^{-1}$ برای نمونه N-۱۰۰۰ وجود دارد که در تطابق با نتایج گزارش شده است [۱۸]. این قله‌ها را بمتربیب به مد کششی در راستای محور C و در صفحه پیوند O-Ni می‌دهند [۲۰، ۱۹]. مقایسه قله‌ها برای نمونه‌های N-۹۲۰ و N-۱۰۰۰ نشان می‌دهد که هر دو قله متاظر با مدahای کششی در صفحه و در راستای محور C به مقدار حدود بین ۲ الی $3 cm^{-1}$ افزایش می‌یابد که نشان می‌دهد پیوند O-Ni در نمونه دارای اندازه بلورک کوچکتر، کوتاه‌تر است. این نتیجه در تطابق با کاهش ثابت‌های شبکه a و c با کاهش دمای بازپخت و اندازه بلورک‌هاست.

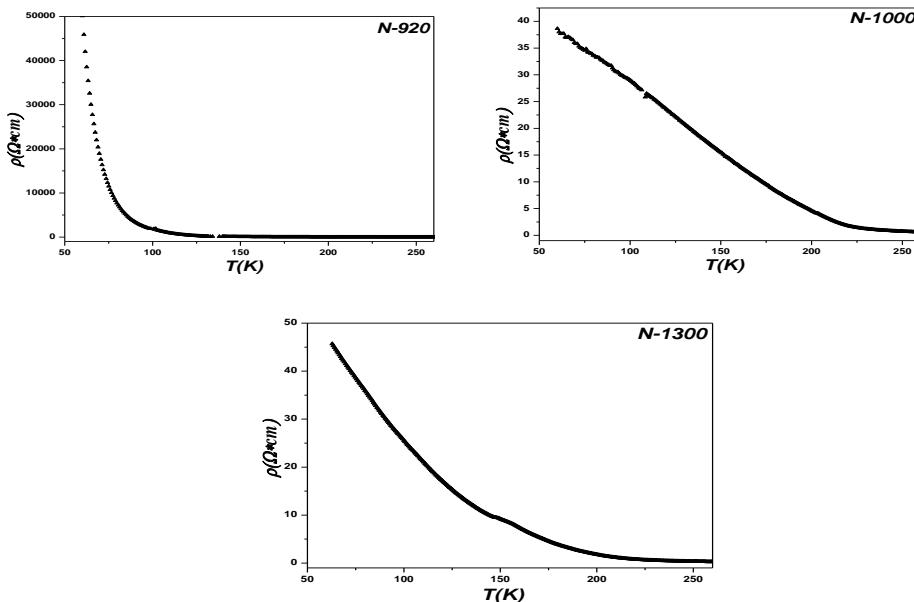


شکل ۹. طیف‌های FTIR برای نمونه‌های N-۹۲۰ و N-۱۰۰۰

اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی

اندازه‌گیری مقاومت ویژه الکتریکی بر حسب دما با روش چهار میله‌ای (دستگاه سرد کن سیکل بسته شرکت Laybold) و بدون اعمال میدان مغناطیسی در بازه دمایی ۶۰ تا ۲۷۰ کلوین برای نمونه‌های N-۹۲۰، N-۱۰۰۰ و N-۱۳۰۰ انجام شد که نتایج آن در شکل ۱۰ نشان داده شده است.

در دماهای زیاد نزدیک دمای اتاق، نمونه‌ها مقاومت ویژه کمی دارند ولی با کاهش دما مشاهده می‌گردد که مقاومت ویژه چندین مرتبه در بزرگی افزایش می‌یابند. این تغییرات در نمونه N-۹۲۰ در دماهای پایین خیلی شدید است. مقدار مقاومت ویژه اندازه‌گیری شده در سه دمای مختلف در جدول ۲ برای مقایسه ارائه شده است. با افزایش دمای بازپخت که با افزایش در اندازه ذرات همراه است، مقاومت ویژه کاهش می‌یابد.



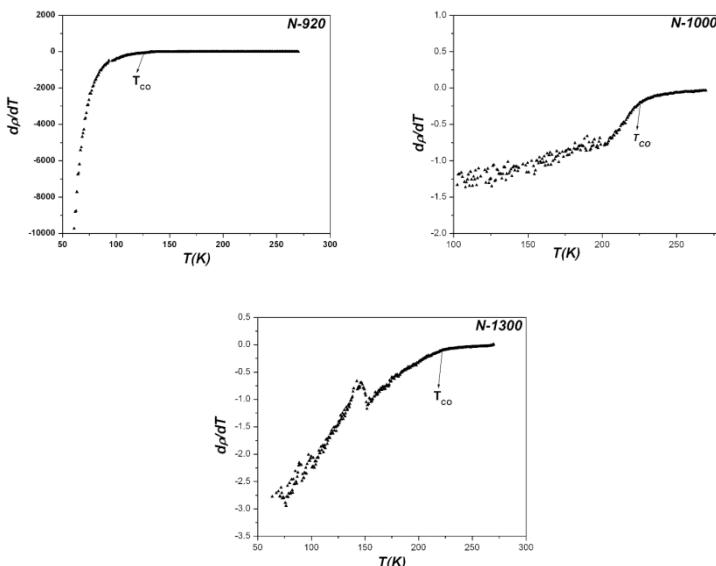
شکل ۱۰. وابستگی مقاومت ویژه به دما برای نمونه‌های N-۹۲۰، N-۱۰۰۰ و N-۱۳۰۰

جدول ۲. اندازه مقاومت ویژه نمونه‌ها بر حسب اهم سانتی‌متر در سه دمای مختلف

دما(کلوین)	۲۶۵	۲۲۵	۲۰۰
نمونه	۰/۶۰	۲/۶۷	۹/۹۷
N-920	۰/۴۰	۱/۰۰	۲/۲۰
N-1000	۰/۲۵	۰/۶۰	۱/۴۳
N-1300	۰/۰۵	۰/۰۵	۰/۰۵

افزایش در مقاومت می‌تواند به علت افزایش پراکندگی حامل‌های بار با کاهش اندازه ذرات باشد. پراکندگی حامل‌ها می‌تواند با کوچکتر شدن ذرات از چگالی زیاد بی‌نظمی مغناطیسی در مرز بین ذرات نیز ناشی شود. با افزایش دمای بازپخت و بنتیع آن افزایش اندازه ذرات، مرز بین آن‌ها کاهش پیدا کرده که در نتیجه کاهش پراکندگی حامل‌ها، مقاومت نیز کاهش می‌یابد [۲۱]. چنان‌که در شکل ۱۰ مشاهده می‌شود، همه نمونه‌ها در دمایی مشخص، افزایشی زیاد در مقدار مقاومت را نشان می‌دهند. با رسم منحنی مشتق دمایی مقاومت ویژه

می‌توان دمای گذار نظم بار را تعیین کرد که $d\rho/dT < 0$ متناظر با یک گذار عایق و $d\rho/dT > 0$ متناظر با گذار فلزی است [۲۲]. رسم نمودارهای $d\rho/dT$ بر حسب T نمونه‌ها در شکل ۱۱ نشان داده شده است. محل تغییر در شیب نمودارها متناظر با دمای گذار به فاز نظم بار است. در این نمودارها جهشی در دماهای کمتر نیز مشاهده می‌شود (خصوصاً در $N-1300$ که واضح‌تر قابل مشاهده است). دمای نظم آنتی فرومغناطیس در آلایش $x=0/33$ و در نمونه حجمی حدود $K-180$ است [۲۱]. بنا بر این جهش مشاهده در نمونه $N-1300$ و در حدود $K-150$ ممکن است ناشی از تأثیر نظم مغناطیسی باشد.



شکل ۱۱. مشتق اول دمایی مقاومت ویژه بر حسب دما برای نمونه‌های $N-920$ ، $N-1000$ و $N-1300$

برای مشخص کردن مکانیزم تراپردازیکی در نمونه‌ها، داده‌های تجربی مقاومت ویژه بر حسب تابعی از دما را با سه مدل جهش پلارون‌های کوچک آدیابتاتیک (ASPH)، پلارون‌های کوچک غیرآدیابتاتیک (NASPH) و جهش با برد متغیر (VRH) برآورد کنیم. مقاومت الکتریکی در مدل ASPH از این رابطه پیروی می‌کند

:[۲۳]

$$\rho = \rho_a T \exp\left(\frac{E_a}{k_B T}\right) \quad (1)$$

در مدل پلارون‌های کوچک غیرآدیابتاتیک (NASPH) با این رابطه بیان می‌شود:

$$\rho = \rho_a T^{\frac{3}{2}} \exp\left(\frac{E_a}{k_B T}\right) \quad (2)$$

که در این روابط E_a انرژی فعال‌سازی و ρ_a پارامتری مستقل از دما است. رسانش بر اساس مدل جهش پلارون‌های کوچک، در دماهایی غالب است که انرژی گرمایی برای بر انگیختن الکترون‌ها به حالت‌های گسترشده فراتر از E_c در نوار رسانش کافی باشد. در این حالت رسانندگی عادی رخ می‌دهد که ناشی از رانش الکترون‌ها در میدان الکتریکی است. در تقریب ادیابتاتیک، فرض می‌شود پلارون‌ها احتمال زیادی برای جهش

به‌مکان بعدی دارند و قبل از برگشت موج فونون، آن‌ها به جلو و عقب می‌جهند. در حالی که در تقریب غیر‌آدیاباتیک، انتظار می‌رود احتمال کمی برای جهش در هر دور تلاش وجود دارد.

رفقار دمایی مقاومت در مدل جهش با دامنه متغیر (VRH) بدین صورت بیان می‌شود:

$$\rho = \rho_0 \exp\left(\frac{T_0}{T}\right)^{\frac{1}{4}} \quad (3)$$

که در رابطه مذکور T_0 بدین صورت است:

$$kT_0 = \frac{24}{\pi N (E_F)^{\frac{5}{3}}}$$

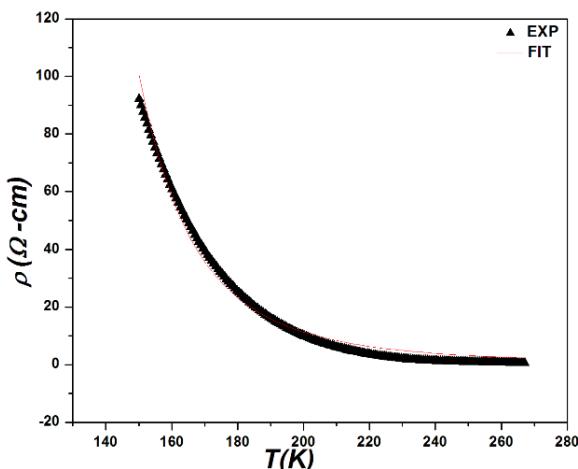
که در آن ξ طول جای‌گزیدگی و $N(E_F)$ چگالی حالت‌ها در تراز فرمی و ρ_0 یک ثابت عددی است [۲۴]. این مدل در نظر می‌گیرد که حالت‌های الکترونی در انرژی فرمی تمامی جای‌گزین شده‌اند و مراکز داماندازی حامل‌ها به‌طور تصادفی در انرژی توزیع شده‌اند. بنا بر این رسانندگی از طریق پرش مستقیم حامل‌ها از یک محل داماندازی به دیگری با کمک تغییرات دمایی شبکه انجام می‌گیرد [۲۱].

برای هر نمونه بهترین برازش را مشخص و نتایج را تجزیه و تحلیل می‌کنیم. چون با توجه به نتایج تجربی، دمای گذار نظم بار به اندازه ذره وابسته است (شکل ۱۱)، بنا بر این بازه دمایی انتخاب شده برای برازش، وابسته به دمای گذار، متفاوت است.

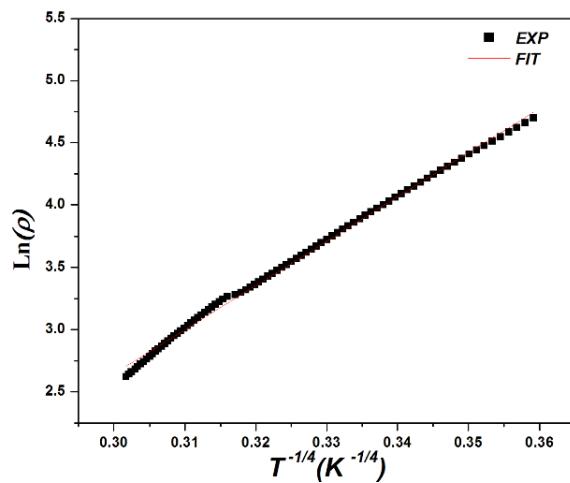
N-920

برای تعیین مکانیزم رسانش الکتریکی در این نمونه، داده‌های تجربی با مدل‌های ASPH، NASPH و VRH برازش گردید. نتایج این برازش نشان داد که در بازه دمایی $K 150$ تا 270 مطابقت نسبتاً خوبی با مدل ASPH وجود دارد، که نتیجه آن در شکل ۱۲ نشان داده شده است. یادآوری می‌گردد که دمای گذار نظم بار به‌دست آمده حدود $K 130$ است که خیلی کمتر از نمونه حجمی است. شکل ۱۲ نشان می‌دهد مدل جهش پلارون‌های کوچک آدیاباتیک در بالای دمای گذار نظم بار، فرآیند غالب رسانش است. انرژی فعال‌سازی E_a را با برازش داده‌های تجربی با مدل ASPH (رابطه ۱) و یافتن پارامترهای برازش محاسبه که در حدود 127 meV است [۲۵].

در ناحیه نظم بار یعنی زیر دمای $K 130$ ، از آن‌جاکه حفره‌ها جای‌گزیده شده‌اند، رسانش الکتریکی از قانون جهش با برد متغیر مات تبعیت می‌کند. چنان‌که در شکل ۱۳ دیده می‌شود داده‌های تجربی با این مدل در بازه دمایی $K 60$ تا $K 120$ مطابقت خوبی دارد.



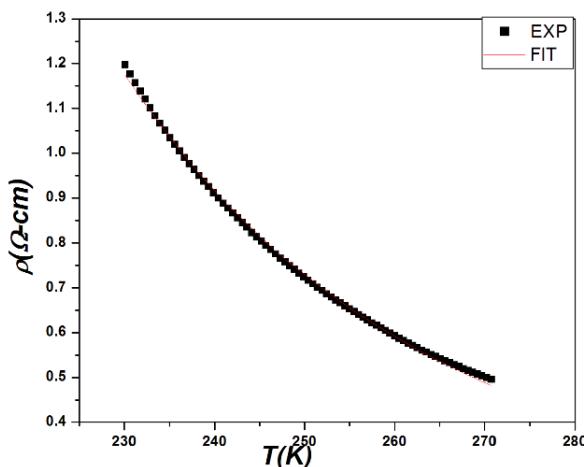
شکل ۱۲. نمودار مقاومت ویژه نمونه N-۹۲۰ در بازه دمایی ۱۵۰ تا ۲۷۰ K و نتیجه برازش آن با مدل ASPH



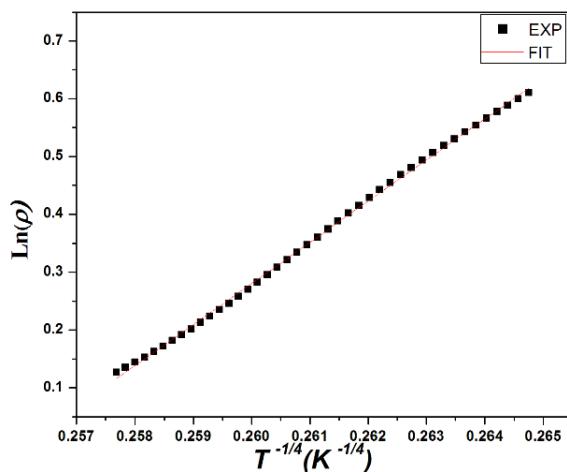
شکل ۱۳. نمودار مقاومت ویژه بر حسب $T^{-1/4}$ و برازش آن با مدل VRH در ناحیه دمایی ۶۰ تا ۲۰ K برای نمونه N-۹۲۰

نمونه N-1000

در این نمونه بعد از برازش داده‌های مقاومت ویژه با مدل‌های ASPH، NASPH و VRH در بالای دمای گذار یعنی بازه دمایی ۲۳۰ تا ۲۷۰ کلوین، در این نمونه نیز مناسب‌ترین مدلی که همچوپانی خوبی با داده‌های تجربی در این بازه دمایی داشت مدل ASPH بود که در شکل ۱۴ قابل مشاهده است. انرژی فعال‌سازی به دست آمده از برازش در حدود ۱۳۹ meV است که کمی بیشتر از نمونه N-۹۲۰ است. اما در زیر دمای گذار و در بازه ۱۹۰ تا ۲۱۷ کلوین مناسب‌ترین تطابق با مدل VRH به دست آمد که در شکل ۱۵ نشان داده شده است.



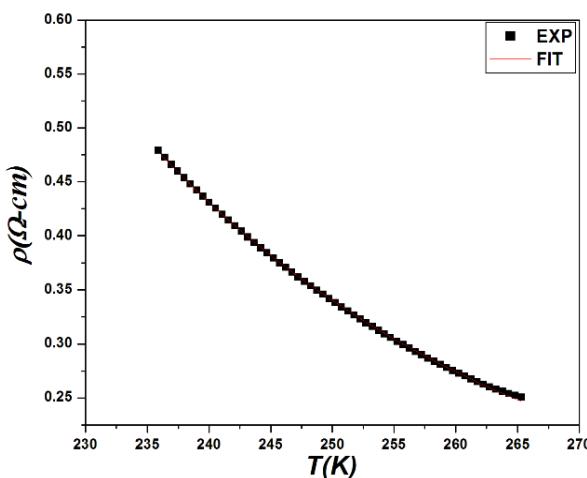
شکل ۱۴. نمودار مقاومت ویژه نمونه N-۱۳۰۰ در بازه دمایی ۲۳۰ تا ۲۷۰ K و نتیجه برآش آن با مدل ASPH



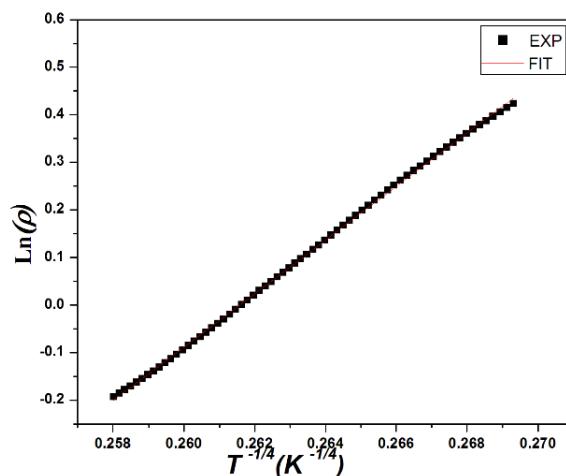
شکل ۱۵. نمودار مقاومت ویژه بر حسب $T^{-1/4}$ برای نمونه N-۱۳۰۰ در بازه دمایی ۱۹۰ تا ۲۱۷ K و نتیجه برآش آن با مدل VRH

نمونه N-1300

برآش مدل‌های مختلف رسانش الکتریکی با داده‌های تجربی برای این نمونه نیز بررسی شد که در بالای دمای گذار یعنی بازه ۲۳۵ تا ۲۷۰ K لوین بهترین برآش با مدل پلارون‌های کوچک آدیاباتیک (ASPH) حاصل شد که تصویر آن در شکل ۱۶ مشاهده می‌شود. انرژی فعال‌سازی پلارون به دست آمده از برآش در حدود ۱۴۴ meV است. این نتیجه نشان می‌دهد که E_a با افزایش اندازه ذره، افزایش یافته است.



شکل ۱۶. نمودار مقاومت ویژه نمونه N-۱۳۰۰ در بازه دمایی ۲۳۵ تا ۲۷۰ K و نتیجه برآزش آن با مدل ASPH در زیر دمای گذار نظم بار، در بازه ۱۹۰ تا ۲۲۵ کلوین، داده‌های تجربی تطابق خوبی را با مدل VRH نشان داد که در شکل ۱۷ نشان داده شده است. برای مقایسه مقادیر بدست آمده از برآزش نمونه‌ها با یکدیگر در بالای دمای گذار، نتایج در جدول ۳ ارائه شده است. E_a انرژی فعال‌سازی و ρ_0 کمیت ثابتی است که به نفوذ و تراکم پولارون وابسته است. چنان‌که در جدول نیز مشاهده می‌شود با افزایش دمای بازپخت و بهتبع آن افزایش در اندازه ذرات انرژی فعال‌سازی افزایش می‌یابد در حالی‌که مقدار ρ_0 کاهش می‌یابد. کاهش مقدار ρ_0 می‌تواند به دلیل افزایش در اندازه ذره و کاهش پراکندگی از مرز دانه‌ها باشد. افزایش انرژی فعال‌سازی برای نمونه‌های N-۱۳۰۰ و N-۱۰۰۰ احتمالاً به این دلیل این است که دمای نظم بار در دماهای بیشتر نسبت به نمونه N-۹۲۰ اتفاق می‌افتد. مقدار $E_a=129$ meV برای نمونه Nd_{1.67}Sr_{0.33}NiO₄ [۲۱] و مقدار $E_a=105$ meV برای نمونه La_{1.75}Sr_{0.25}NiO₄ گزارش شده است [۲۵]. نتایج حاصل از این کار در باره نوع مکانیزم غالب رسانش الکتریکی در بازه‌های دمایی متفاوت با کارهای انجام شده دیگر هم خوانی دارد [۲۱].



شکل ۱۷۰. مقایسه نمودار مقاومت ویژه بر حسب $T^{-1/4}$ در بازه دمایی ۱۹۰ تا ۲۲۵ K و نتیجه برآزش آن با مدل VRH

جدول ۳ مقادیر ثابت به دست آمده از برآش داده‌ها با رابطه (۱)

نمونه \ ثابت	$\rho_a(\Omega\text{cm}/\text{K})$	$E_a(\text{meV})$
N-920	3×10^{-5}	۱۲۷
N-1000	0.46×10^{-5}	۱۳۹
N-1300	0.18×10^{-5}	۱۴۴

برای مقایسه مقادیر به دست آمده از برآش نمونه‌ها با یکدیگر در زیر دمای گذار، نتایج در جدول ۴ ارائه شده است. مقادیر ρ_a نشان می‌دهد که با کاهش اندازه ذره در حد ابعاد نانومتر (نمونه N-۹۲۰) مقدار ρ_a که معرف مقاومت باقی‌مانده نیز است چندین مرتبه افزایش می‌یابد که می‌تواند به دلیل پراکندگی از مرزدانه‌ها باشد. مقدار T_0 این نمونه نانوذره، نشان می‌دهد که چگالی حالت‌ها در تراز فرمی برای این نمونه بزرگ‌تر از نمونه‌های دیگر است.

جدول ۴. مقادیر ثابت به دست آمده از برآش داده‌ها با رابطه (۳)

نمونه \ ثابت	$\rho(\Omega\text{cm})$	$T_0(K)$
N-920	$2/35 \times 10^{-4}$	$1/6 \times 10^9$
N-1000	$1/25 \times 10^{-8}$	$25/6 \times 10^6$
N-1300	$40/9 \times 10^{-8}$	10×10^6

از مقایسه تحلیل نتایج نمونه‌ها با یکدیگر می‌توان نتیجه گرفت، از آنجاکه با کاهش دمای بازپخت و کاهش اندازه ذرات، چگالی مرز بین ذره‌ها افزایش پیدا می‌کند، پراکندگی حامل‌ها افزایش یافته و در نتیجه مقاومت ویژه با کاهش دمای بازپخت، افزایش می‌یابد. همچنین می‌توان گفت که مکانیزم رسانش الکتریکی در بالا و زیر دمای گذار نظم بار، متفاوت است. همچنین دمای گذار نظم بار به اندازه ذره حساس و کاهش اندازه ذره باعث جلوگیری از نظم بار و جابه‌جایی دمای گذار نظم بار به دماهای کمتری می‌شود.

نتیجه‌گیری

نیکلایت $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ به روش سل-ژل و با اندازه‌های ذره مقاومت تهیه و ساختار بلوری و خصوصیات فیزیکی آن‌ها با تکنیک‌های XRD، FTIR، FESEM و اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بررسی شدند. نتایج XRD و بررسی مورفولوژی سطح نمونه‌ها با SEM نشان داد که کمترین دمای بازپختی که در آن فاز خالص تتراگونال مورد نظر تشکیل می‌شود، ۹۲۰ درجه سانتی‌گراد است. با افزایش دمای بازپخت، اندازه بلورک‌ها افزایش یافت. اندازه‌گیری طیف عبور اپتیکی (FTIR) نمونه‌ها نشان داد طول پیوند O-Ni-O در نمونه

دارای اندازه بلورک کوچکتر، کوتاه‌تر است که این نتیجه در تطابق با کاهش ثابت‌های شبکه a و c با کاهش دمای بازپخت و اندازه بلورک‌ها است.

با تغییر دمای آماده‌سازی سل به ژل مشخص شد هر چه دمای آماده‌سازی سل به ژل افزایش یابد اندازه ذارت نیز افزایش می‌یابد. با بررسی نتایج حاصل از تأثیر دمای خشکسازی نمونه‌ها مشخص شد با کاهش دما و افزایش زمان خشکسازی، مورفولوژی سطح بهتر و ولی تغییر خاصی در اندازه ذرات مشاهده نشد. اما با تغییر حلال آب با الكل، نه تنها اندازه ذرات کاهش نیافت بلکه یکنواختی ذرات نیز کمتر شد. خواص الکتریکی و دمای گذار نظم بار با اندازه‌گیری مقاومت الکتریکی بررسی شد. مشاهده شد با افزایش در اندازه ذرات، مقاومت ویژه با کاهش پراکندگی حامل‌های بار کاهش می‌یابد. با رسم نمودار دمایی مقاومت ویژه و مشتق آن، دمای گذار نظم بار برای نمونه‌های N-۹۲۰، N-۱۰۰۰ و N-۱۳۰۰ به ترتیب ۱۳۰، ۲۲۰ و ۲۳۰ کلوین به دست آمد. از آنجاکه دمای گذار وابسته به روش ساخت و میکرو ساختار است، مشاهده شد با افزایش اندازه ذرات، دمای گذار نظم بار به سمت دمایی بیشتر جای‌جا شد.

تشکر و قدردانی

از آقای دکتر کاملی و همکارانشان در دانشگاه صنعتی اصفهان برای اندازه‌گیری‌های مقاومت کمال تشکر را داریم.

منابع

1. Ghazi M. E., Spencer P. D., Wilkins S. B., Hatton P. D., Mannix D., Prabhakaran D., Boothroyd A. T., Cheong S. W., "Incommensurate charge stripe ordering in $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ for $x= (0.33, 0.30, 0.275)$ ", Phys. Rev. B 70 (2004).
2. Spencer P. D., Ghazi M. E., Wilkins S. B., Hatton P. D., Brown S. D., Prabhakaran D., Boothroyd A. T., "Charge stripe glasses in $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ for $0.20 < x < 0.25$ ", Eur. Phys. J. B 46 (2005) 27-32.
3. Anisimov V. I., Korotin M. A., Zaanen J., "Spin bags, polarons, and impurity potentials in $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ from first principles", Phys. Rev. Lett. 68 (1992).
4. Hayden S. M., Lander G. H., Zarestky J., "Incommensurate magnetic correlations in $\text{La}_{1.8}\text{Sr}_{0.2}\text{NiO}_4$ ", Phys. Rev. Lett. 68 (1992).
5. Aeppli G. and Buttrey D. J., "Magnetic Correlations in $\text{La}_2\text{NiO}_{4+\delta}$ ", Phys. Rev. Lett. 61 (1988).
6. Vaknin D., Sinha S. K., Moncton D. E., "Antiferromagnetism in $\text{La}_2\text{CuO}_{4-y}$ ", Phys. Rev. Lett. 58 (1987).

7. Wakimoto S., Shirane G., Endoh Y., Hirota K., Ueki S., Yamada K., Birgeneau R. J., Kastner M. A., Lee Y. S., Gehring P. M., Lee S. H., "Observation of incommensurate magnetic correlations at the lower critical concentration for superconductivity in $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ ($x=0.05$)", Phys. Rev. B 60 (1999).
8. Matsuda M., Fujita M., Yamada K., Birgeneau R. J., Kastner M. A., Hiraka H., Endoh Y., Wakimoto S., Shirane G., "Static and dynamic spin correlations in the spin-glass phase of slightly doped $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ ", Phys. Rev. B 62 (2000).
9. Bi X. X., Eklund P. C., "Polaron contribution to the infrared optical response of $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_{4+\delta}$ and $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_{4+\delta}$ ", Phys. Rev. Lett. 70 (1993).
10. Wochner P., Tranquada J. M., Buttrey D. J., et al., "Neutron-diffraction study of stripe order in $\text{La}_2\text{NiO}_{4+\delta}$ with $\delta=2/15$ ", Phys. Rev. B 57 (1998).
11. Lee S. H., Cheong S. W., Yamada K., "Charge and canted spin order in $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ ($X=0.275$ and $1/3$)", Phys. Rev. B 6306 (2001).
12. Ben Achour Z., Ktari T., Ouertani B., Touayar O., Bessais B., BenBrahim, "Effect of doping level and spray time on zinc oxide thin films produced by spray pyrolysis for transparent electrodes applications", J. Sensors and Actuators A. 134 (2007) 447-451.
13. Dumeignil F., Sato K., Imamura M., Matsabayashi N., Payen E., Shimada H., "Modification of structural and acidic properties of sol-gel-prepared alumina powders by changing the hydrolysis ratio Applied Catalysis A: General 241" (2003) 319-329.
14. Gwang D., Guo F., ChenJ.f., shao L., Liu H., Zhang Z. T; "A two-step way to synthesize nano inner-modified aluminum trihydroxide A: physisochemical and Engineering Aspects 293" (2007) 201-209.
15. Kwon S., Messing G. L., "The effect of particle solubility on the strength of nanocrystalline agglomerates Nanostruct", Mater.8 (1997) 399-418.
16. Brinker C. J., Scherer G. W., "Sol-Gel Science: The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing", Academic Press Inc., San Diego (1990).
17. Iskandar F., Gradon L., Okuyama K., "Control of the morphology of nanostructured particles prepared by the spray drying of a nanoparticle sol", J. Colloid Interface Sci. 265 (2003) 296-303.

18. Zhao, J., Shi, L., He, L., Guo, Y., Zhou, S., "Ferromagnetism Enhanced by Lattice Distortion in Fine $\text{La}_{5/3}\text{Sr}_{1/3}\text{NiO}_4$ Particles", *J Supercond. & Nov. Magn.* 23 (2010) 411-415.
19. Stavola, M., Cava, R. J., Rietman, E. A., "Evidence for a Peierls distortion in La_2CuO_4 from vibrational spectroscopy", *Phys. Rev. Lett.* 58 (1987).
20. Gervais, F., Echegut, P., Bassat, J. M., Odier, P., "Analysis of infrared reflection spectra of oxides of the La_2CuO_4 high- T_c superconductor family in polarized light", *Phys. Rev. B* 37 (1988).
21. Zaghouani M., Giovannelli F., Pruvost S., Poirier N., Monot-Laffez I., "Magnetic and transport properties of $\text{Nd}_{1.67}\text{Sr}_{0.33}\text{NiO}_4$ ", *J. of Mag. & Mag. Mat.* 305 (2006) 71-75.
22. Siwach P. K, Gautam U. K., Srivastava, Singh H. K., Tiwari R. S., Srivastava O. N., "Colossal magnetoresistance study in nanophase $\text{La}_{0.7}\text{Ca}_{0.3}\text{MnO}_3$ mangnite", *J. Phys. D: Appl. Phys.* 39 (2006) 14-20.
23. Emin D., "Studies of small-polaron motion IV. Adiabatic theory of the Hall effect", *Ann. Phys.*, 53 (1969).
24. Sir Nevill Mott "Conduction in Non-Crystalline Materials", Clarendon Press, Oxford (1993).
25. Wu G, Neumeier J., "Small polaron transport and pressure dependence of the electrical resistivity of $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{NiO}_4$ ($0 < \sim x < \sim 1.2$)", *J. Phys. Rev. B* 67 (2003).